

طراحی و ساخت آنتن مایکرواستریپ سه بانده و دوپلاریزه برای BTS

خاطره مرادی^۱ سعید نیکمهر^۲

۱- مربی، دانشکده انرژی، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

kh.moradi@kut.ac.ir

۲- دانشیار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

nikmehr@tabrizu.ac.ir

چکیده: در این مقاله، یک آنتن پچ مایکرواستریپ سه بانده با پلاریزاسیون دوگانه، شامل یک پچ مستطیلی، با برش هایی در هر چهار لبه ارائه می شود، که برای بکارگیری در ایستگاه پایه موبایل مناسب است. یکی از باندها، GSM900، و باند دیگر DCS1800 و UMTS2100 را پوشش می دهد. آنتن ارائه شده دیکوپلینگ پورت خوبی، کمتر از -30dB- برای پلاریزاسیون دوگانه خطی، در باندهای عملکرد از خود نشان می دهد. ساختار آنتن بر اساس پیکربندی پشتیایی با تغذیه کوبلینگ روزنهای طراحی شده و دارای دو تغذیه برای دستیابی به پلاریزاسیون دوگانه است که بر روی دو لایه مجزا و بصورت عمود برهم قرار گرفته اند. آنتن با استفاده از نرم افزار HFSS شبیه سازی شده و با تغییر قسمت های موثر بصورت پارامتری، در نهایت عملکرد سه بانده و دوپلاریزه تنها با یک المان تشعشعی و دو پورت تغذیه بدست آمده است. ماکریم گین بدست آمده نیز حدود 11.9dBi در باند پایین، و 7dBi در باند بالا است.

کلمات کلیدی: آنتن مایکرواستریپ؛ دو بانده؛ دوپلاریزه؛ GSM؛ DCS؛ UMTS

تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۸۹/۱۰/۲۶

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۱/۱۰/۲۷

نام نویسندهی مسئول: خاطره مرادی

نشانی نویسندهی مسئول: ایران - کرمانشاه - میدان آزادگان - ابتدای شهرک پردبیس - دانشگاه صنعتی کرمانشاه - دانشکده انرژی

۱- مقدمه

تا کنون آنتن‌های مایکرواستریپ گوناگونی به عنوان آنتن ایستگاه پایه گزارش شده‌اند. برخی از این آنتن‌ها مختص استفاده در هر باند بطور جداگانه بوده‌اند. که از این میان بعضی دارای یک پلاریزاسیون و بعضی نیز دارای پلاریزاسیون دوگانه هستند. بعضی آنتن‌ها نیز دو یا چند بانده بوده و آن‌ها نیز ممکن است پلاریزاسیون تکی یا دوگانه داشته باشند. تعداد محدودی تک المان دو بانده با پلاریزاسیون دوگانه وجود دارند که البته هنوز بصورت آرایه گزارش نشده‌اند [۶]. در [۷]، یک آنتن پچ دو بانده و پهن باند با برش‌هایی در دو لبه ارائه شده است اما این طرح قابلیت پلاریزاسیون دوگانه را ندارد. طرح ارائه شده در [۸] یک آنتن پچ دو پلاریزه و دو بانده است که باندهای GSM900 و DCS1800 را پوشش می‌دهد. آنتن [۲] نیز یک آنتن دو پلاریزه و دو بانده با باندهای مشابه با طرح این مقاله است، اما برای هر باند و هر پلاریزاسیون از پورت تغذیه مجزا استفاده شده و آنتن در مجموع دارای ۴ پورت تغذیه و ساختار نسبتاً پیچیده‌ای است.

۲- پیکربندی آنتن

طرح اولیه بر مبنای یک ساختار پشتۀای با تغذیه کوپلینگ شکافی با یک شکاف صلیبی شکل بروی صفحه زمین آن، قرار داده شد. ساختار آنتن ارائه شده همراه با تصویر آنتن ساخته شده در شکل ۱ نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشاهده می‌شود، جهت داشتن آنتنی که در سه باند فرکانسی تشعشع کند، یک پچ مستطیلی با برش‌هایی در هر ۴ لبه بالاترین لایه یک ساختار چند لایه قرار گرفته است. شکل پچ را مشابه [۷] انتخاب کرده و در نهایت ابعاد بهینه با تحلیل پارامتری بدست آمدند. مکانیزم اصلی رفتار دو بانده، (باند دوم پهن باشد) این پچ، ابعاد متفاوت طول و عرض و برش‌های روی آن‌ها فرکانس‌های رزونانس بالا و پایین می‌توانند کنترل شوند. بعد از شبیه سازی اولیه، با اضافه کردن یک استتاب کوچک به پچ نتایج بهتری بدست آمد و با بهینه سازی، شکل نهایی پچ بصورت شکل (الف) درآمد.

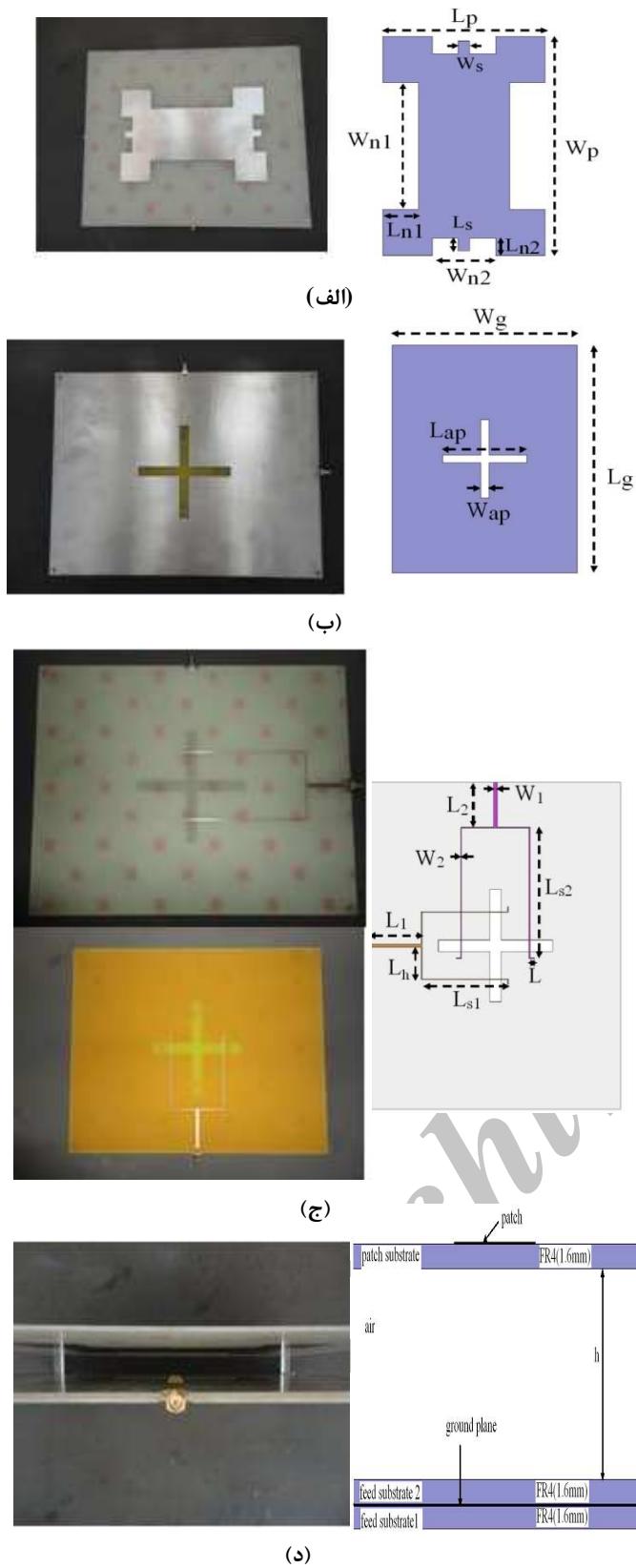
بعد از مشخص شدن شکل پچ، جنس و ضخامت زیر لایه‌ها باید تعیین شود. انتخاب درست برای ضرایب دیالکتریک این زیرلایه‌ها بسیار مهم است. معمولاً برای بالا بردن پهنای باند، ϵ_r مربوط به المان تشعشع کننده کم و ضخامت آن بزرگ انتخاب می‌شود و از طرفی ϵ_r مربوط به زیرلایه تغذیه را بزرگ و ضخامت آن را کوچک می‌گیرند تا تشعشع از خطوط تغذیه کمتر و پهنای خطوط باریکتر شود. اما علاوه بر مسئله پهنای باند ملاحظات دیگری از جمله مسئله ساخت نیز باید در نظر گرفته شود، بنابراین هرچند با توجه به توضیح فوق بهتر است دو زیرلایه متفاوت برای پچ و خطوط تغذیه استفاده شوند که زیرلایه پچ ضریب دیالکتریک پایین و زیرلایه تغذیه، ضریب دیالکتریک بالا داشته باشند، اما برای امکان پذیری هرچه بیشتر ساخت، و همچنین داشتن آنتنی سبک و ارزان، دو زیرلایه از نوع FR4

در سال‌های آتی، نسل جدید سیستم‌های ارتباطی بی‌سیم، آنتن‌های ایستگاه پایه جدید و بهبود یافته‌ای را تقاضا خواهند کرد. آنتن‌های آنتن‌های روی یک ایستگاه پایه را کاهش دهند [۱]. برای سرعت بخشی به این فرآیند، در بیشتر موارد مناسب است که از سایت‌های یکسان استفاده کرده و آن‌ها را با دکل‌هایی که هنوز برای سیستم نسل‌های قبل بکار می‌روند مجهز نمود. بنابراین مطلوب است که آنتن‌های چندباندهای داشته باشیم که قادرند از باندهای قدیمی به باندهای جدید تغییر کاربری بدهند. در اروپا این یعنی تقاضا برای المان‌های آنتنی که قادرند در باندهای GSM، DCS و UMTS کار کنند [۲].

بطور کلی وقتی عدم فضای کافی برای داشتن ابزارهای چند کاره، یک محدودیت غالب است، المان‌های تشعشعی چندبانده یا پهن باند، واقعاً مورد نیاز هستند مثلاً در ابزارهای موبایل و یا در تاسیسات ایستگاه پایه، هنگامی که آنتن‌ها بایستی روی ساختمان‌هایی نصب شوند که نمی‌توانند با اجسام زیاد از شکل بیافتدند، این نیاز بیشتر احساس می‌شود. مخصوصاً اگر آنتن‌ها بزرگ و مزاحم باشند [۳]. در این میان آنتن‌های پچ مایکرواستریپ دارای ویژگی‌های برتر زیادی از قبیل سادگی ذاتی برای ساخت و تولید انبو، هزینه تولید کم، وزن سبک و کوچکی و... بوده که آنها را به یک گزینه مناسب برای بسیاری از کاربردها و از جمله برای کاربردهای مخابرات سیار، تبدیل می‌سازد. پیشرفت‌های اخیر، طراحی و توسعه آنتن‌های مایکرواستریپ را ضروری ساخته و از این میان، دستیابی به عملکرد دو یا چند فرکانسی در کنار ویژگی‌های دیگری از قبیل فشردگی، پهنای باند بالا و داشتن پلاریزاسیون دوگانه خطی یا دایروی، از اهمیت خاصی برخوردار است [۴].

همچنین علاوه بر نیاز برای المان‌های چندبانده، اغلب مطلوبست که سیستم آنتن قادر به جبران تنزل سیگنال به خاطر پیچیدگی کانال انتشار و اثرات مخرب محوشده چندمسیری^۱ باشد. یکی از کاراترین تکنیک‌ها، برای رفع این مشکل دایورسیتی پلاریزاسیون^۲ نامیده می‌شود، که شامل استفاده از سیستم‌های آنتن جندتایی بوده و دو مولفه به اندازه کافی ناهمبسته سیگنال را دریافت کرده و آنها را بطور مناسبی در گیرنده ترکیب می‌کند تا نسبت سیگنال به نویز را افزایش دهد [۳]. آنتن‌های مایکرواستریپ فشرده که قادر به تشعشع دو پلاریزه باشند، برای کاربرد در سیستم‌های مخابراتی بی‌سیم که متقاضی استفاده مجدد فرکانسی و دایورسیتی پلاریزاسیون می‌باشند، بسیار مناسبند [۵].

هدف مقاله حاضر ارائه یک تک المان سه بانده که به منظور قرارگیری در یک ترکیب آرایه‌ای طراحی شده مناسب باشد.



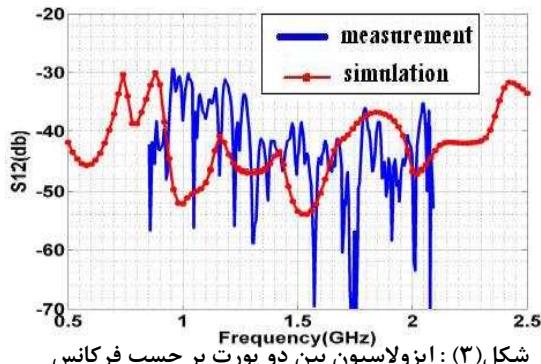
شکل (۱): پیکربندی آتن و تصویر آتن ساخته شده (الف) شکل پچ
 (ب) روزنه‌های کوپلینگ روی صفحه زمین (ج) شبکه‌های تغذیه
 مایکرواستریپ دو طرف صفحه زمین (د) نمای جانبی زیرلایه‌ها

با $\epsilon_r = 4.4$ انتخاب شدند. همچنین اگرچه طبق توضیح فوق، انتخاب ضخامت کمتر برای زیرلایه تغذیه بهتر است و طرح پیشنهادی نیز ابتدا با ضخامت ۰.۸mm برای لایه‌های تغذیه طراحی شد، اما از آنجا که زیرلایه باریک منجر به پنهانی کم برای خطوط تغذیه شده و ساخت را مشکل می‌سازد، لذا از زیرلایه با ضخامت ۱.۶mm برای زیر لایه‌های تغذیه استفاده می‌شود. بنابراین در نهایت، برای هر سه زیرلایه، FR4 با

ضخامت استاندارد ۱.۶ mm انتخاب شد.

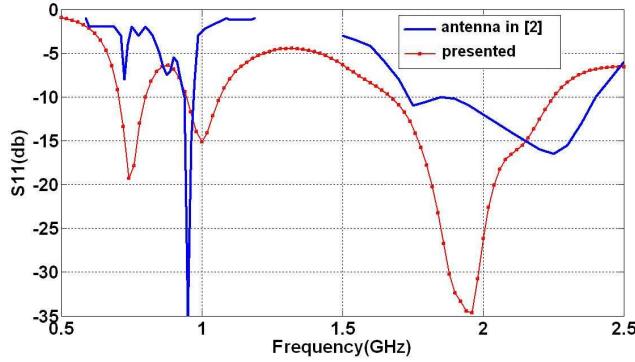
ضمن اینکه برای افزایش پنهانی باند، یک لایه هوا بین زیرلایه‌های تغذیه و زیر لایه پچ قرار گرفت که می‌توان با پایه‌های پلاستیکی، لایه‌ها را نسبت به هم ثابت نگه داشت و یا به جای هوا از فوم‌های رایج که دارای ثابت دیالکتریک نزدیک به یک هستند استفاده کرد. که ارتفاع اولیه لایه هوا ۲۶mm بوده و در نهایت با بهینه سازی ارتفاع آن ۱۷mm قرار داده شد. نمای جانبی زیرلایه‌ها، همراه با جنس و ارتفاع آنها در شکل (۱(د)) نشان داده شده است. به منظور دستیابی به تشعشع دو پلاریزه، از تکنیک تغذیه دولایه استفاده کرده و دو شبکه تغذیه در دو طرف مقابل صفحه زمین و روی این دولایه در جهت عمود بر هم قرار می‌گیرند. برای باقی ماندن هرچه بیشتر تقارن سعی می‌شود که دو شبکه تغذیه یکسان باشند. هر شبکه تغذیه برای تحریک یکی از بازوهای شکاف صلیبی بکار می‌رود. هر شبکه بصورت یک خط تغذیه مایکرواستریپی $50\text{ }\Omega$ اهمی است که قبل از رسیدن به شکاف صلیبی شکل به دو شاخه $100\text{ }\Omega$ تقسیم می‌شود تا با خط موازی شکاف صلیبی تداخل نداشته باشد. دو شاخه بطور متقاضن قرار می‌گیرند تا تولید قطبیش متقاطع نکنند. فاصله آنها نیز بایستی به اندازه کافی دور از بخش موازی شکاف صلیبی باشد تا کوپلینگ قابل توجهی داشته باشد. از آنجا که زیرلایه‌های هر دو شبکه تغذیه یکسان هستند، ($\epsilon_r = 4.4$ و $h=1.6mm$) پس ضخامت خطوط هر دو شبکه تغذیه یکسان است. در اینجا برای هر پورت تغذیه از یک روزنه مستطیلی روی صفحه زمین استفاده می‌شود تا انرژی را از خط تغذیه به پچ کوپل کرده و اندازه آن نیز برای افزایش پنهانی باند نسبتاً بزرگ باشد تا به یک روزنه رزونانسی تبدیل شود. این دو روزنه مستطیلی برای دو پورت تغذیه، به صورت عمود بر هم قرار می‌گیرند تا پلاریزاسیون خطی عمود بر هم داشت. بنابراین با عمود قرار گرفتن دو روزنه مستطیلی بطور متقاضن، یک شکاف صلیبی روی صفحه زمین ایجاد می‌شود و از آنجا که تقارن یک مسئله مهم در طراحی آتن‌های دو پلاریزه به منظور دستیابی به ایزولاسیون بالا بین دو پورت است، بنابراین شکاف صلیبی با بازویی برابر در مرکز صفحه زمین و زیر مرکز پچ قرار می‌گیرد. البته باید توجه داشت که بطور کلی آتن‌هایی که از تغذیه کوپلینگ روزنه‌ای استفاده می‌کنند، اندازه F/B کمتری نسبت به سایر انواع تغذیه دارند.

دو پورت در هر سه باند کمتر از 40 dB بوده که استاندارد لازم را برآورده کرده و ایزو لاسیون کامل دو پورت از یکدیگر را تایید می‌کند.



شکل(۳): ایزو لاسیون بین دو پورت بر حسب فرکانس

شکل (۴) نیز یک مقایسه را بین تلف بازگشتی آنتن ارائه شده و آنتن [۲] نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود آنتن ارائه شده در این مقاله، علاوه بر داشتن دو پورت تغذیه کمتر، تلف بازگشتی به مراتب بهتری نسبت به آنتن [۲] دارد.



شکل(۴): مقایسه بین تلف بازگشتی آنتن ارائه شده و آنتن [۲]

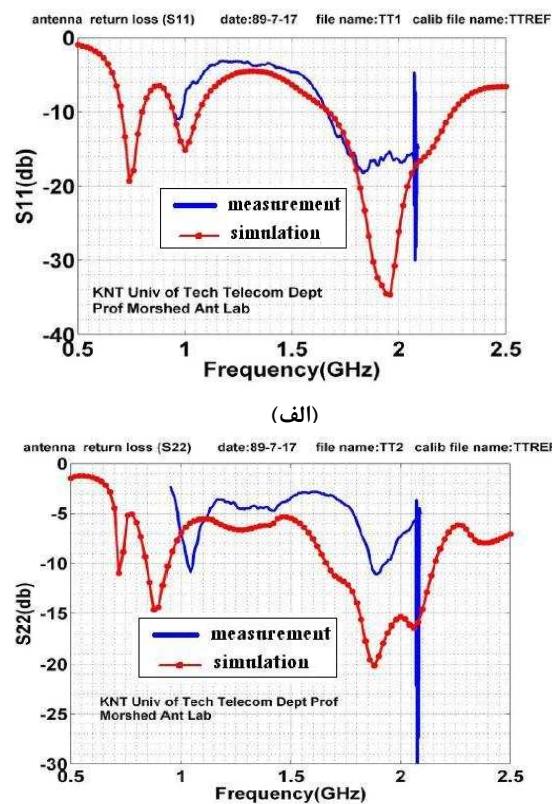
نتایج شبیه‌سازی و اندازه‌گیری پترن تشعشعی دو بعدی تک المان در فرکانس‌های مرکزی هر سه باند یعنی 920 MHz، 1800MHz، 2045MHz و 2045MHz، در هر دو صفحه E ($\phi=0^\circ$) و H ($\phi=90^\circ$)، به ترتیب در شکل‌های (۱۰-۳)، (۱۱-۳) و (۱۲-۳) نشان داده شده‌اند. که پترن‌ها در صفحه E دارای پهنای بیم نصف توان 63 °، 85 ° و 64 ° در صفحه H دارای پهنای بیم نصف توان 44 °، 56 ° و 32 °، به ترتیب در فرکانس‌های مرکزی سه باند هستند. یک دلیل اصلی اختلاف بین مقادیر شبیه‌سازی و اندازه‌گیری استفاده از زیرلایه FR4 است. تلفات این ماده در فرکانس‌های بالا زیاد بوده و ثابت دی الکتریک آن خیلی ناپایدار است. نایراین در عمل اختلاف نسبتاً زیادی با شبیه‌سازی ایجاد می‌شود. که با توجه به اینکه نتایج ساخت نیز ویژگی‌های اصلی موردنظر را تا حد قابل قبولی برآورده می‌کنند، می‌توان از اختلاف موجود چشم پوشی نمود.

کارایی آنتن بر حسب فرکانس در شکل (۶) رسم شده و شکل (۷) نیز تغییرات گین آنتن تک المان بر حسب فرکانس را در دو باند بالا و پایین نشان می‌دهد. ماکزیمم گین در باند پایین برابر 11.8dB_i و ماکزیمم گین در باند بالا 6.9dB_i هستند. همانطور که مشاهده

در اینجا نیز، استفاده از این روزنه‌ها با ابعاد بزرگ می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر اندازه F/B منجر شود که با قرای دادن صفحه زمین در پشت آنتن آن را کاهش داد.

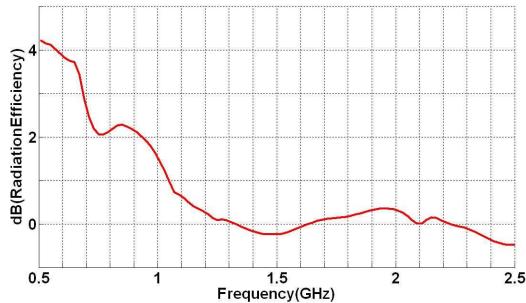
۳- بحث

ساختار طراحی شده در محیط نرم افزاری HFSS پیاده سازی شد و بعد از بهینه‌سازی ابعاد، نتایج طبق شکل‌های زیر به دست آمدند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی و اندازه‌گیری برای افت بازگشتی آنتن در هر دو پورت در شکل (۲) نشان داده شده‌اند. همانطور که مشاهده می‌شود، DCS (1800MHz)، GSM (900MHz) و UMTS (2100MHz) با پهنای باند لازم پوشش داده می‌شوند. پهنای باند امپدانسی بدست آمده بر اساس تعریف 2 ρ، برای پورت ۱، برای باند GSM، DCS و UMTS 620 MHz یا 32.6% و برای پورت ۲ و باند 480 MHz، GSM و DCS 125 MHz یا 14.1% و باندهای UMTS 24.7% است.

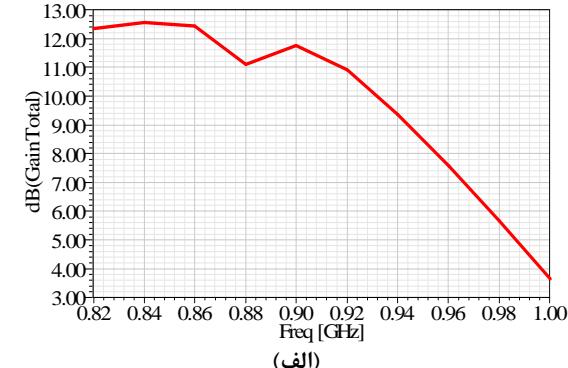


شکل(۲): تلف بازگشتی بر حسب فرکانس (الف) پورت ۱(ب) پورت ۲
 $L_p=115\text{mm}$, $W_p=190\text{mm}$, $L_{n1}=25\text{mm}$, $W_{n1}=110\text{mm}$, $L_{n2}=15\text{mm}$,
 $W_{n2}=45\text{mm}$, $L_s=10\text{mm}$, $W_s=8\text{mm}$, $L_g=290\text{mm}$, $W_g=220\text{mm}$,
 $L_{ap}=100\text{mm}$, $W_{ap}=10\text{mm}$, $L_1=45\text{mm}$, $L_2=40\text{mm}$, $W_1=3.06\text{mm}$,
 $W_2=0.7\text{mm}$, $L_{s1}=75\text{mm}$, $L_{s2}=115\text{mm}$, $L_h=30.24\text{mm}$, $L=5\text{mm}$, $h=17\text{mm}$

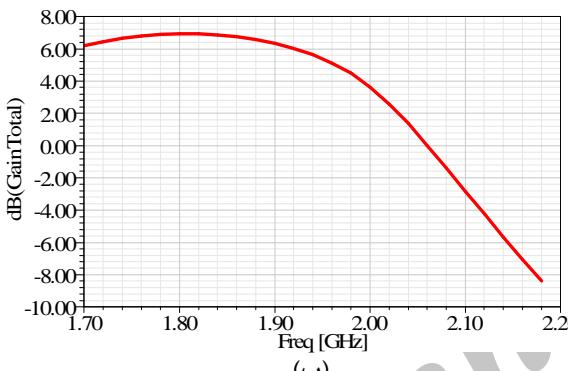
نتایج شبیه‌سازی و اندازه‌گیری برای ایزو لاسیون بین دو پورت نیز در شکل (۳) نشان داده شده است. مطابق این شکل، ایزو لاسیون بین



شکل (۶): تغییرات بازده تک المان بر حسب تغییرات فرکانس

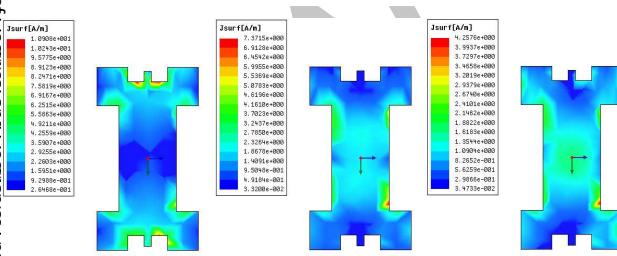


(الف)



(ب)

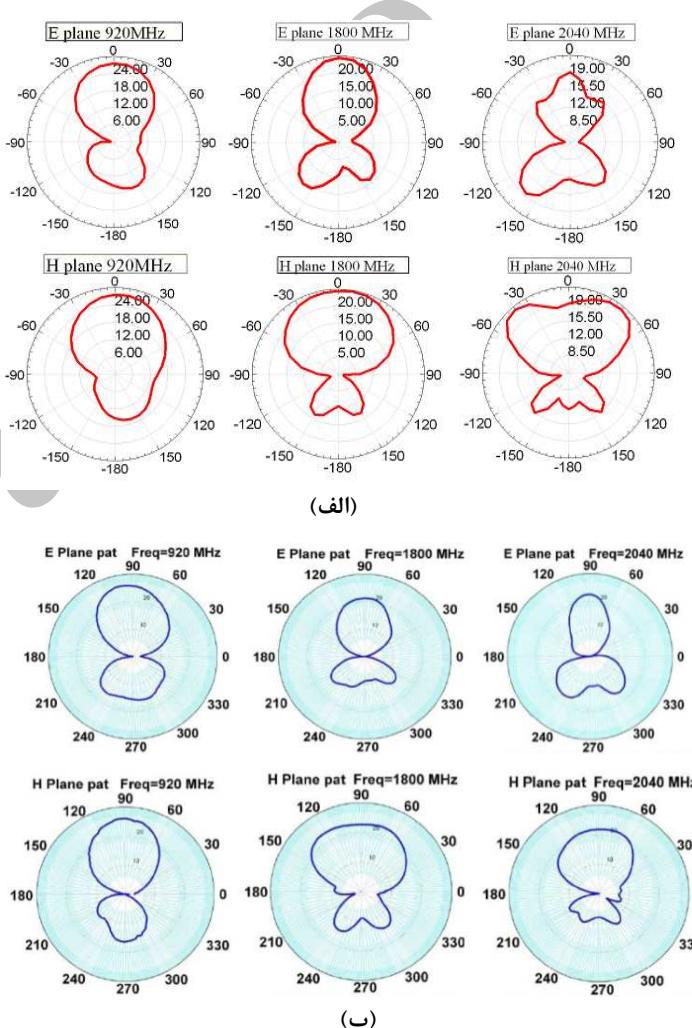
شکل (۷): تغییرات گین تک المان بر حسب تغییرات فرکانس
(الف) باند پایین (ب) باند بالا



شکل (۸): توزیع جریان سطحی روی پچ (الف) 900MHz

(ب) 2040MHz (ج) 1800MHz

می شود تک المان طراحی شده گین بالایی مخصوصا در باند پایین دارد که آن را برای ایستگاه پایه مناسب می سازد. توزیع جریان سطحی روی پچ در شکل (۸) نشان می دهد که طول پچ برش خورده یعنی L_D ، فاکتور اصلی برای تعیین رزونانس روزانه پایین است و توزیع جریان در 1850MHz و 2080MHz نیز بیان می کنند که رزونانس مقابله بین روزنه روی زمین و پچ برش خورده، فاکتور اصلی برای پهن کردن پهنهای باند در فرکانس رزونانس بالاست. یعنی فرکانس کاری پایین با تغییر ابعاد برش روی طول پچ (L_D و W_{n1} و W_{n2})، و رزونانس بالا با تغییر ابعاد برش روی عرض پچ (W_D و L_{n2}) کنترل می شود. ضمن اینکه اندازه روزنه و ارتفاع فوم کنترل کننده پهنهای باند هستند.



شکل (۵): پترن های تشعشعی صفحه E و H در فرکانس های 920MHz و 2040MHz و 1800MHz (الف) شبیه سازی (ب) اندازه گیری

در این مقاله تک المانی طراحی شد که ضمن پوشش دادن سه باند فرکانسی GSM، DCS و UMTS، دارای پلاریزاسیون دوگانه خطی ۹۰ درجه بود.

۴- نتیجه گیری

در این مقاله تک المانی طراحی شد که ضمن پوشش دادن سه باند فرکانسی UMTS.DCS.GSM، دارای پلاریزاسیون دوگانه خطی^۱ و ۹۰ درجه بود. برای این تک المان از دو تغذیه کوپلینگ شکافی در دو لایه مجزا و یک پچ تشعشعی مستطیلی با برش هایی در چهار لبه استفاده شد. از همان ابتدا، طراحی با در نظر گرفتن ملاحظات ساخت از نظر هزینه و سادگی صورت گرفت تا تک المان طراحی شده ضمن برآورده کردن ویژگی های تشعشعی مناسب و پهنهای باند و ایزوولاسیون لازم، قابلیت ساخت آسان و کم هزینه را نیز داشته باشد. بنابراین زیرلایه ها ($E_r = 4.4$) و با ضخامت ۱.۶mm انتخاب شدند تا ضمن ارزان بودن و در دسترس بودن، ضخامت خطوط تغذیه نیز خیلی باریک نبوده و ساخت را مشکل نسازد. نتایج بدست آمده برای این تک المان از نظر پارامترهای مختلف آنتن در جدول (۱) خلاصه شده اند.

اولین مزیت کلی که می توان برای این آنتن مطرح کرد ارائه عملکرد سه باند و دوبلاریزه، تنها با یک المان تشعشعی است که با بکارگیری بجای استقرار آنتن های هرسه باند به طور جداگانه، باعث صرفه جویی در هزینه و فضا می شود. ضمن اینکه داشتن دو پلاریزاسیون خطی عمود برهمنمود، امکان استفاده از دایورسیتی پلاریزاسیون بجای دایورسیتی فضا در ایستگاه های پایه را فراهم کرده و این خود عامل مهمی در کاهش فضا و هزینه می باشد.

همچنین در مقایسه با کارهای مشابه انجام شده در این زمینه، ساختار فوق دارای ابعاد نسبتا کوچک، تعداد لایه های کم و ساختار ساده ای است که استفاده از زیر لایه FR4 به سادگی و هزینه کم ساخت و سبکی ساختار کمک بسیاری خواهد نمود. استفاده از فقط یک پورت تغذیه برای هر پلاریزاسیون در هر سه باند فرکانسی و در مجموع بکار گیری تنها دو پورت تغذیه نیز از دیگر مزایای این طرح نسبت به کارهای مشابه است.

مهمترين عيب اين ساختار، تشبع به پشت نسبتا زياد است که همانطور که گفته شد در ساختارهای با کوپلینگ روزنایي اجتناب ناپذير است و بايستي با تكينيك های مختلفي آن را به حداقل رساند. در اين آنتن نيز به علت استفاده از تغذие کوپلینگ روزنایي که به منظور دستيابي به پهنهای باند بالا انتخاب شد، تشبع رو به پشت در پترن ها قابل مشاهده است که استفاده از روزنه بزرگ روزنانسي ميزان اين تشبع را بيشتر کرده است. ضمن اين که باید توجه کرد که اين تک المان به منظور قرارگیری در يك ترکيب آرایه ای طراحی شده است بنابراین شكل پترن ها را می توان به شكل مطلوب برای ایستگاه پایه رساند.

UMTS2100	DCS1800	GSM900	
32.6%	14.6%	پورت ۱	پهنهای باند
24.7%	14.1%	پورت ۲	
64°	85°	63°	افقی $\phi = 0$
32°	44°	56°	عمودی $= 90$
7dBi	11.8dBi		گین
≤ -35dB	≤ -43dB	≤ -45dB	ایزوولاسیون بین دو پورت
0 & 90°	0 & 90°	0 & 90°	پلاریزاسیون
4.1dB	23.1dB	21.2	F/B
≤ 2	≤ 2	≤ 2	VSWR
22cm×29cm×21.4cm			ابعاد

مراجع

- [1] Z. N. Chen and K. M. Luk, Antennas For Base Stations in Wirelees Communications, McGrawHill, 2009.
- [2] V. Deillion, J-F. Zu" rcher, and A. K. Skrivervik, "A Compact Dual-band Dual-Polarized Antenna Element for GSM/DCS/UMTS base stations," Microwave and Optical Technology. Lett., Vol.40, No.1, pp. 29-33, Jan 2004.
- [3] A. A. Serra, P. Nepa, G.Manara, G. Tribellini and S. Cioci, "A Wide-Band Dual-Polarized Stacked Patch Antenna," IEEE Trans and Wireless Propagation Letters, Vol.6, pp.141-143, 2007.
- [4] A. K. Singh, and M. k. Meshram, "Slot-Loaded Shorted Patch for Dual-Band Operation," Microwave and Optical Technology Letters,Vol.50,No.4, pp.1010-1017, April 2008.
- [5] V. Voipio, "Dual Band Dual Polarized Basestation Antenna FDTD Design Study," IEEE Antennas and Propagation International Symposium, pp.2337-2340, June 2007.
- [6] N. Amiri , K. Forooraghi, "Dual-band and dual-polarized microstrip array antenna for GSM900/DCS1800 MHz base stations," IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium 2006.
- [7] K. Oh, B. Kim and J. Choi,"Design of dual and wideband apertur stacked patch antenna with double-sided notches," Electronic Lett., Vol.40, No.11, May 2004.
- [8] T.W.Chiou and K.L.Wong, "A compact dual-band dual-polarized patch antenna for 900/1800-MHz cellular systems," IEEE Trans. Antennas Propagate., Vol.51, No.8, PP.1936-1940, August 2003.

¹ multipath fading

² polarization diversity

³ Global System for Mobile Communication

⁴ Digital Communication System

⁵ Universal Mobile Telecommunication System